

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-145281

(P2004-145281A)

(43) 公開日 平成16年5月20日(2004.5.20)

(51) Int.CI.⁷

F 1

テーマコード(参考)

G09G 3/30

G09G 3/30

J

3K007

G09G 3/20

G09G 3/30

K

5C080

H03K 17/00

G09G 3/20

611H

5J055

H05B 33/14

G09G 3/20

612G

G09G 3/20

624B

審査請求 未請求 請求項の数 33 O L (全 23 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2003-207376(P2003-207376)

(22) 出願日

平成15年8月12日(2003.8.12)

(31) 優先権主張番号

特願2002-255251(P2002-255251)

(32) 優先日

平成14年8月30日(2002.8.30)

(33) 優先権主張国

日本国(JP)

(71) 出願人

000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(74) 代理人

100095728

弁理士 上柳 雅善

(74) 代理人

100107076

弁理士 藤綱 英吉

(74) 代理人

100107261

弁理士 須澤 修

(72) 発明者

宮澤 貴士

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB17 AB18 BA06 DB03 GA00

最終頁に続く

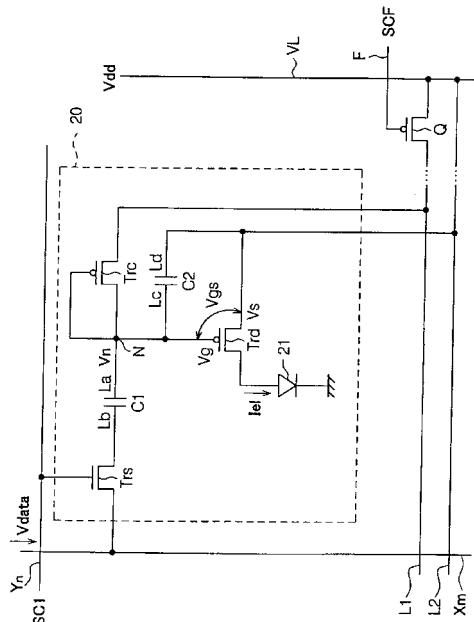
(54) 【発明の名称】電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】トランジスタの閾値電圧のばらつきを低減することができる電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供する。

【解決手段】駆動トランジスタ T_{rd} 、調整用トランジスタ T_{rc} 及びスイッチングトランジスタ T_{rs} からなる3つのトランジスタと、第1キャパシタ C_1 及び第2キャパシタ C_2 からなる2つのコンデンサとで画素回路20を構成した。又、調整用トランジスタ T_{rc} のソースは、他の画素回路20の調整用トランジスタ T_{rc} のソースとともにアクティブマトリクス部の右端側に設けられた駆動電圧 V_{dd} を供給する電圧供給線 V_L と制御用トランジスタ Q を介して接続した。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、
第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御
用端子に接続された第2のトランジスタと、
第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された
容量素子と、
第5の端子と第6の端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3の
トランジスタと
を含む単位回路を複数有し、

前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源
線に接続され、
前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧
との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回
路。

【請求項 2】

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、
第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御
用端子に接続された第2のトランジスタと、
第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された
容量素子と、
第5の端子と第6の端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3の
トランジスタと

を含む単位回路を複数有し、
前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源
線に接続され、
前記第2の端子は第2の電源線に接続され、
前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧
との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回
路。

【請求項 3】

請求項1または2に記載の電子回路において、
前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項 4】

請求項1乃至3のいずれかに記載の電子回路において、
前記単位回路の各々には、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第
3のトランジスタ以外のトランジスタはないことを特徴とする電子回路。

【請求項 5】

請求項1乃至4のいずれか1つに記載の電子回路において、前記第1のトランジスタと前
記第2のトランジスタの導電型は同じであることを特徴とする電子回路。

【請求項 6】

請求項1乃至5のいずれか1つに記載の電子回路において、前記第1の端子には電子素子
が接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項 7】

請求項6に記載の電子回路において、
前記電子素子が電流駆動素子であることを特徴とする電子回路。

【請求項 8】

請求項1乃至7のいずれか1つに記載の電子回路において、前記制御回路は、第7の端子
と第8の端子とを備えた第4のトランジスタであり、
前記第7の端子は前記第1の電源線を介して前記第4の端子に接続されるとともに、前記

10

20

30

40

50

第8の端子は前記駆動電圧に接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項9】

請求項1乃至8のいずれか1つに記載の電子回路において、前記第2の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能であることを特徴とする電子回路。

【請求項10】

請求項1乃至9のいずれか1つに記載の電子回路において、前記第1のトランジスタの閾値電圧は前記第2のトランジスタの閾値電圧より低くならないように設定されていることを特徴とする電子回路。

【請求項11】

複数の第1の信号線と、複数の第2の信号線と、複数の電源線と、複数の単位回路と、を含む電子回路であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、

第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御用端子に接続された第2のトランジスタと、

第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、

第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3のトランジスタと

を含み、

10

前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続され、

前記第3の制御用端子は前記複数の第1の信号線のうち対応する第1の信号線に接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項12】

請求項11に記載の電子回路において、

前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、

前記第2の端子は第2の電源線に接続され、

前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回路。

20

30

【請求項13】

請求項11又は12に記載の電子回路において、

前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの導電型は同じであることを特徴とする電子回路。

【請求項14】

請求項11乃至13のいずれか1つに記載の電子回路において、

前記第1の端子には電子素子が接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項15】

複数の単位回路を備えた電子回路において、

前記複数の単位回路の各々は、

信号を電荷として保持する保持素子と、

前記保持素子への前記信号の伝送を制御するスイッチングトランジスタと、前記保持素子に保持された電荷に基づいて導通状態が設定される駆動トランジスタと、

前記保持素子への前記信号の伝送に先立って前記駆動トランジスタの制御用端子を所定の電位に設定する調整用トランジスタと

を含み、

40

前記複数の単位回路のうち少なくとも2つの単位回路の前記調整用トランジスタに駆動電圧を供給する制御回路と

を備えたことを特徴とする電子回路。

50

【請求項 16】

請求項 15 に記載の電子回路において、

前記駆動トランジスタには電子素子が接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項 17】

第 1 の端子と第 2 の端子と第 1 の制御用端子とを備えた第 1 のトランジスタと、

第 3 の端子と第 4 の端子とを備え、前記第 1 の制御用端子に前記第 3 の端子が接続された第 2 のトランジスタと、

第 1 の電極と第 2 の電極とを備え、前記第 1 の制御用端子に前記第 1 の電極が接続された容量素子と

を含む複数の単位回路を備えた電子回路の駆動方法であって、

前記複数の単位回路の前記各第 3 の端子を所定電位に電気的に接続するとともに前記第 1 の制御用端子を第 1 の電位に設定する第 1 のステップと、

前記第 3 の端子を前記所定電位から電気的に切断した状態で、前記第 2 の電極の電位を第 2 の電位から第 3 の電位に変化させることにより前記第 1 の制御用端子を前記第 1 の電位から変化させる第 2 のステップと

を含むことを特徴とする電子回路の駆動方法。

【請求項 18】

請求項 17 に記載の電子回路の駆動方法において、

少なくとも前記第 1 のステップを行っている期間は前記第 2 の電極の電位を前記第 2 の電位に設定した状態とすることを特徴とする電子回路の駆動方法。

【請求項 19】

複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、

第 1 の端子と第 2 の端子と第 1 の制御用端子とを備えた第 1 のトランジスタと、

前記第 1 の端子と接続された電気光学素子と、

第 3 の端子と第 4 の端子とを備え、前記第 3 の端子が前記第 1 の制御用端子に接続された第 2 のトランジスタと、

第 1 の電極と第 2 の電極とを備え、前記第 1 の電極が前記第 1 の制御用端子に接続された容量素子と、

第 5 の端子と第 6 の端子と第 3 の制御用端子とを備え、前記第 5 の端子が前記第 2 の電極に電気的に接続された第 3 のトランジスタと、

を含み、

前記第 4 の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第 4 の端子と共に第 1 の電源線に接続され、

前記第 3 の制御用端子は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続され、前記第 6 の端子は、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続され、前記第 1 の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第 1 の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 20】

複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、

第 1 の端子と第 2 の端子と第 1 の制御用端子とを備えた第 1 のトランジスタと、

前記第 1 の端子と接続された電気光学素子と、

第 3 の端子と第 4 の端子とを備え、前記第 3 の端子が前記第 1 の制御用端子に接続された第 2 のトランジスタと、

第 1 の電極と第 2 の電極とを備え、前記第 1 の電極が前記第 1 の制御用端子に接続された容量素子と、

第 5 の端子と第 6 の端子と第 3 の制御用端子とを備え、前記第 5 の端子が前記第 2 の電極に電気的に接続された第 3 のトランジスタと、

を含み、

10

20

30

40

50

前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、

前記第2の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第2の端子と共に第2の電源線に接続され、

前記第3の制御用端子は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続され、

前記第6の端子は、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項21】

請求項19または20に記載の電気光学装置において、

10

前記第2のトランジスタは、第2の制御用端子を備え、

前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項22】

請求項19乃至21のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記制御回路は、第7の端子と第8の端子とを備えた第4のトランジスタであり、

前記第7の端子は、前記第1の電源線を介して前記第4の端子と接続されるとともに、前記第8の端子は前記駆動電圧に接続されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項23】

請求項19乃至22のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

20

前記単位回路の各々には、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタ以外のトランジスタはないことを特徴とする電気光学装置。

【請求項24】

請求項19乃至23のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの導電型は同じであることを特徴とする電気光学装置。

【請求項25】

請求項19乃至24のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記第1のトランジスタの閾値電圧は前記第2のトランジスタの閾値電圧より低くならないよう設定されていることを特徴とする電気光学装置。

30

【請求項26】

請求項19乃至25のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記第2の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能であることを特徴とする電気光学装置。

【請求項27】

請求項19乃至26のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記電気光学素子はEL素子であることを特徴とする電気光学装置。

【請求項28】

請求項19乃至27のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記走査線に沿って、同色の電気光学素子が配置されるようにしたことを特徴とする電気光学装置。

40

【請求項29】

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、

前記第1の端子に接続された電気光学素子と、

第3の端子と第4の端子とを備え、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、

第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の制御用端子に前記第1の電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線の交差部に対応して配置された電気光学装置の駆動方法であって、

前記複数の単位回路のうち、前記複数の走査線の一つの走査線に第3の制御用端子が接続

50

された第3のトランジスタを含む一連の単位回路の前記第3の端子を前記第4の端子及び前記第2のトランジスタのチャネルを介して所定電位に電気的接続することにより、前記第1の制御用端子を第1の電位に設定する第1のステップと、

前記一連の単位回路の前記第3の制御用端子に前記第3のトランジスタをオン状態とする走査信号を供給して、前記第3のトランジスタをオン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前記対応するデータ線及び前記第3のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記第2の電極に印加することにより、前記第2の電極の電位を第2の電位から第3の電位に変化させることで前記第1の制御用端子の電位を前記第1の電位から変化させる第2のステップを含み、

前記第2のステップにおいて、前記データ信号を前記第2の電極に印加する期間と前記一連の単位回路の前記第3の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期間とが少なくとも1部重なるように設定することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。 10

【請求項30】

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、

前記第1の端子に接続された電気光学素子と、

第3の端子と第4の端子とを備え、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、

第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の制御用端子に前記第1の電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線の交差部に対応して配置され、 20

前記複数の単位回路のうち、前記複数の走査線の一つの走査線に第3の制御用端子が接続された第3のトランジスタを含む一連の単位回路の前記第4の端子が、全て複数の第1の電源線のうちの一つの第1の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、前記一連の単位回路の前記第4の端子を所定電位に電気的接続することにより、前記第1の制御用端子を第1の電位に設定する第1のステップと、

前記一連の単位回路の前記第3の制御用端子に前記第3のトランジスタをオン状態とする走査信号を供給して、前記第3のトランジスタをオン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前記対応するデータ線及び前記第3のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記第2の電極に印加することにより、前記第2の電極の電位を第2の電位から第3の電位に変化させることで前記第1の制御用端子の電位を前記第1の電位から変化させる第2のステップを含み、 30

前記第2のステップにおいて、前記データ信号を前記第2の電極に印加する期間と前記一連の単位回路の前記第4の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期間とが少なくとも1部は重なるように設定することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項31】

請求項29または30に記載の電気光学装置の駆動方法において、

少なくとも前記第1のステップを行っている期間は前記第2の電極の電位を前記第2の電位に設定した状態とすることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項32】

請求項1乃至16のいずれか1つに記載の電子回路を実装したことを特徴とする電子機器。 40

【請求項33】

請求項19乃至28のいずれか1つに記載の電気光学装置を実装したことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器に関するものである。

【0002】

10

20

30

40

50

【従来の技術】

近年、広く表示装置として用いられる複数の電気光学素子を備えた電気光学装置は、高精
彩化あるいは大画面化が求められており、これに呼応して、複数の電気光学素子の各々を
駆動するための画素回路を備えたアクティブマトリクス駆動型電気光学装置のパッシブ駆
動型電気光学装置に対する比重はより高まっている。しかしながら、より一層の高精
彩化あるいは大画面化を達成するためには、電気光学素子をそれぞれ精密に制御する必要
がある。そのためには、画素回路を構成する能動素子の特性バラツキを補償しなければなら
ない。

【0003】

能動素子の特性バラツキの補償方法として、例えば、特性バラツキを補償するための、ダ
イオード接続したトランジスタを含む画素回路を備えた表示装置（例えば、特許文献1を
参照）が提案されている。10

【特許文献1】特開平11-272233号公報**【発明が解決しようとする課題】**

ところで、能動素子の特性バラツキを補償する画素回路は、一般に4つ以上のトランジス
タにより構成され、そのため、歩留まりや開口率の低下を招くこととなる。

【0004】

本発明の一つの目的は、上記問題点を解消することであって、画素回路、あるいは単位回
路を構成するトランジスタの個数を削減することができる電子回路、電子回路の駆動方法
、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供することにある。20

【0005】**【課題を解決するための手段】**

本発明の第1の電子回路は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1
のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端
子が前記第1の制御用端子に接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極
とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、第5の端子
と第6の端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3のトランジス
タとを含む単位回路を複数有し、前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路
の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に
設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御す
る制御回路を備えていることを特徴とする。30

【0006】

上記の電子回路において、前記第2の端子を前記第1の電源線に接続してもよいし、前記
第1の電源線とは異なる第2の電源線に接続するようにしてもよい。

【0007】

本発明の第2の電子回路は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1
のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端
子が前記第1の制御用端子に接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極
とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、第5の端子
と第6の端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3のトランジス
タとを含む単位回路を複数有し、前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路
の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第2の端子は第2の電源線に接続さ
れ、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動
電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えている。40

【0008】

上記の電子回路のような構成することにより、前記単位回路を構成するトランジスタ数を
削減することができる。

【0009】

上記の電子回路において、前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続されていること
が好ましい。50

【 0 0 1 0 】

例えば、前記第3の端子を及び前記第2の制御用端子をそれぞれドレイン及びゲートとすることが好ましい。こにより、前記第2のトランジスタを前記第1のトランジスタの閾値電圧を補償するトランジスタとして用いることができる。

【 0 0 1 1 】

上記の電子回路において、前記単位回路の各々には、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタ以外のトランジスタは含まれていないことが好ましい。

【 0 0 1 2 】

これにより、前記第1のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、前記単位回路のトランジスタ数を削減することができる。 10

【 0 0 1 3 】

上記の電子回路において、前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの導電型は同じであることが好ましい。

【 0 0 1 4 】

これによれば、第2のトランジスタの閾値電圧を調整することによって容易に第1のトランジスタの閾値電圧を補償することができる。

【 0 0 1 5 】

上記の電子回路において、前記第1の端子には電子素子が接続されていてもよい。

【 0 0 1 6 】

上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗素子、ダイオード、記憶素子等である。 20

【 0 0 1 7 】

上記の電子回路において、前記制御回路は、第7の端子と第8の端子とを備えた第4のトランジスタであり、前記第7の端子は前記第1の電源線を介して前記第4の端子に接続されるとともに、前記第8の端子は前記駆動電圧に接続されている。

【 0 0 1 8 】

これによれば、制御回路を容易に構成することができる。

【 0 0 1 9 】

上記の電子回路において、前記第2の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能であってもよい。 30

【 0 0 2 0 】

上記の電子回路において、前記第1のトランジスタの閾値電圧は前記第2のトランジスタの閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。

【 0 0 2 1 】

これによれば、第1のトランジスタの閾値を確実に補償することができる。

【 0 0 2 2 】

また、前記第2のトランジスタを用いて前記第1のトランジスタの閾値補償を行った際でも、前記第1のトランジスタは非導通状態に設定することができる。 40

【 0 0 2 3 】

逆に上記の電子回路において、前記第1のトランジスタの閾値電圧を前記第2のトランジスタの閾値電圧以上としてもよい。

【 0 0 2 4 】

この場合、前記第2のトランジスタを用いて前記第1のトランジスタの閾値補償を行っただけで、前記第2のトランジスタをオン状態とすることができます。

【 0 0 2 5 】

本発明の第3の電子回路は、複数の第1の信号線と、複数の第2の信号線と、複数の電源線と、複数の単位回路と、を含む電子回路であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御用端子に接続

された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に接続された第3のトランジスタとを含み、前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続され、前記第3の制御用端子は前記複数の第1の信号線のうち対応する第1の信号線に接続されている。

【0026】

上記の電子回路において、前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第2の端子は第2の電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることが好ましい。

10

【0027】

これによれば、前記単位回路を構成するトランジスタ数を削減することができる。

【0028】

上記の電子回路において、前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの導電型は同じであることが好ましい。

【0029】

これによれば、第2のトランジスタの閾値電圧を調整することによって容易に第1のトランジスタの閾値電圧を補償することができる。

【0030】

上記の電子回路において、前記第1の端子には電子素子が接続されていてもよい。

20

【0031】

上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗素子、ダイオード、記憶素子等である。

【0032】

上記の電子回路において、前記第1のトランジスタの閾値電圧は前記第2のトランジスタの閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。

【0033】

上記の電子回路において、逆に上記の電子回路において、前記第1のトランジスタの閾値電圧を前記第2のトランジスタの閾値電圧以下としてもよい。

【0034】

本発明の第4の電子回路は、複数の単位回路を備えた電子回路において、前記複数の単位回路の各々は、信号を電荷として保持する保持素子と、前記保持素子への前記信号の伝送を制御する第1のスイッチングトランジスタと、前記保持素子に保持された電荷に基づいて導通状態が設定される駆動トランジスタと、前記保持素子への前記信号の伝送に先立つて前記駆動トランジスタの制御用端子を所定の電位に設定する調整用トランジスタとを含み、前記複数の単位回路のうち少なくとも2つの単位回路の前記調整用トランジスタに駆動電圧を供給する制御回路とを備えていることを特徴とする。

30

【0035】

上記の電子回路において、前記駆動トランジスタには電子素子が接続されていてもよい。

【0036】

上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗素子、ダイオード、記憶素子等である。

40

【0037】

本発明の電子回路の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子とを備え、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の制御用端子に前記第1の電極が接続された容量素子とを含む複数の単位回路を備えた電子回路の駆動方法であって、前記複数の単位回路の前記各第3の端子を所定電位に電気的に接続するとともに前記第1の制御用端子を第1の電位に設定する第1のステップと、前記第3の端子を前記所定電位から電気的に切断した状態で、前記第2の電極の電位を

50

第2の電位から第3の電位に変化させることにより前記第1の制御用端子を前記第1の電位から変化させる第2のステップとを含む。

【0038】

これによれば、第1のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、前記電子回路を構成するトランジスタ数を削減することができる。、

上記の電子回路の駆動方法において、少なくとも前記第1のステップを行っている期間は前記第2の電極の電位を前記第2の電位に設定した状態とすることが好ましい。

【0039】

なお、上記の電子回路の駆動方法において、「前記第3の端子を所定電位に電気的に接続する」とは、例えば、前記第3の端子に前記第4の端子を介して電流が流れ込む状態を言い、前記第3の端子を所定電位に電気的に切断する」とは、例えば、前記第4の端子を介して電流が流れ込まない状態を言う。

【0040】

本発明の第1の電気光学装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、前記第1の端子と接続された電気光学素子と、第3の端子と第4の端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御用端子に接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に電気的に接続された第3のトランジスタと、を含み、前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第3の制御用端子は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続され、前記第6の端子は、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする。

【0041】

本発明の第2の電気光学装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、前記第1の端子と接続された電気光学素子と、第3の端子と第4の端子とを備え、前記第3の端子が前記第1の制御用端子に接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の電極が前記第1の制御用端子に接続された容量素子と、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを備え、前記第5の端子が前記第2の電極に電気的に接続された第3のトランジスタと、を含み、前記第4の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第4の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第2の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第2の端子と共に第2の電源線に接続され、前記第3の制御用端子は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続され、前記第6の端子は、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第1の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えた。

【0042】

上記の電気光学装置によれば、第1のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、画素回路を構成するトランジスタ数を削減することができる。

【0043】

これは、一画素の開口率を向上させ、製造の歩留まりを向上させることができる。

【0044】

上記の電気光学装置において、前記第2の制御用端子は前記第3の端子に接続されていることが好ましい。

【0045】

上記の電気光学装置において、前記制御回路は、第7の端子と第8の端子とを備えた第4

10

20

30

40

50

のトランジスタであり、前記第7の端子は、前記第1の電源線を介して前記第4の端子と接続されるとともに、前記第8の端子は前記駆動電圧に接続されている。

【0046】

これによれば、制御回路を簡単な構成することができる。

【0047】

上記の電気光学装置において、前記単位回路の各々には、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタ以外のトランジスタはないことが好ましい。

【0048】

これによれば、高い開口率を有する電気光学装置を提供することができる。

10

【0049】

上記の電気光学装置において、前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの導電型は同じである。

【0050】

これによれば、第1のトランジスタの閾値電圧を確実に補償することができる。

【0051】

上記の電気光学装置において、前記第1のトランジスタの閾値電圧は前記第2のトランジスタの閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。

【0052】

具体的には、前記第1のトランジスタは、そのゲート長が画素内で対応する前記第2のトランジスタのゲート長より短くならない様に設定されていてもよい。

【0053】

或いは、前記第1のトランジスタは、そのゲート絶縁膜が画素内で対応する前記第2のトランジスタのゲート絶縁膜より薄くならない様に設定されていてもよい。

【0054】

或いは、前記第1のトランジスタは、チャネルに注入される不純物濃度を調整して、その閾電圧が画素内で対応する前記第2のトランジスタの閾電圧より低くならない様に設定されていてもよい。

【0055】

前記第1のトランジスタは飽和領域で動作することが好ましい。

30

【0056】

これによれば、画素回路に設けられた第1のトランジスタの閾値電圧を確実に補償することができる。従って、電気光学素子の輝度階調を精度良く制御することができる。

【0057】

逆に上記の電気光学装置において、前記第1のトランジスタの閾値電圧を前記第2のトランジスタの閾値電圧以下となるように設定してもよい。

【0058】

上記の電気光学装置において、前記第2の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能である。

【0059】

上記の電気光学装置において、前記電気光学素子は、例えば、EL素子である。

40

【0060】

上記の電気光学装置において、前記走査線に沿って、同色の電気光学素子が配置されるようになることが好ましい。

【0061】

本発明の第1の電気光学装置の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、前記第1の端子に接続された電気光学素子と、第3の端子と第4の端子とを備え、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の制御用端子に前記第1の電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線

50

の交差部に対応して配置された電気光学装置の駆動方法であって、前記複数の単位回路のうち、前記複数の走査線の一つの走査線に第3の制御用端子が接続された第3のトランジスタを含む一連の単位回路の前記第3の端子を前記第4の端子及び前記第2のトランジスタのチャネルを介して所定電位に電気的接続することにより、前記第1の制御用端子を第1の電位に設定する第1のステップと、前記一連の単位回路の前記第3の制御用端子に前記第3のトランジスタをオン状態とする走査信号を供給して、前記第3のトランジスタをオン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前記対応するデータ線及び前記第3のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記第2の電極に印加することにより、前記第2の電極の電位を第2の電位から第3の電位に変化させることで前記第1の制御用端子の電位を前記第1の電位から変化させる第2のステップを含み、前記第2のステップにおいて、前記データ信号を前記第2の電極に印加する期間と前記一連の単位回路の前記第3の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期間とが少なくとも1部重なるように設定することを特徴とする。
10

【0062】

本発明の第2の電気光学装置の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを備えた第1のトランジスタと、前記第1の端子に接続された電気光学素子と、第3の端子と第4の端子とを備え、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、第1の電極と第2の電極とを備え、前記第1の制御用端子に前記第1の電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線の交差部に対応して配置され、前記複数の単位回路のうち、前記複数の走査線の一つの走査線に第3の制御用端子が接続された第3のトランジスタを含む一連の単位回路の前記第4の端子が、全て複数の第1の電源線のうちの一つの第1の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、前記一連の単位回路の前記第4の端子を所定電位に電気的接続することにより、前記第1の制御用端子を第1の電位に設定する第1のステップと、前記一連の単位回路の前記第3の制御用端子に走査信号を供給して、前記第3のトランジスタをオン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前記対応するデータ線及び前記第3のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記第2の電極に印加することにより、前記第2の電極の電位を第2の電位から第3の電位に変化させることで、前記第1の制御用端子の電位を前記第1の電位から変化させる第2のステップを含み、前記第2のステップにおいて、前記データ信号を前記第2の電極に印加する期間と前記一連の単位回路の前記第4の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期間とが少なくとも1部は重なるように設定する。
20

【0063】

上記の電気光学装置の駆動方法において、少なくとも前記第1のステップを行っている期間は前記第2の電極の電位を前記第2の電位に設定した状態としておくことが好ましい。

【0064】

これにより、前記第1の制御用端子の電位を前記データ信号に応じた電位に正確に設定することができる。

【0065】

本発明の第1の電子機器は、上記の電子回路を実装したことを特徴とする。
40

【0066】

本発明における第2の電子機器は、上記の電気光学装置を実装したことを特徴とする。

【0067】

上記の発明において、第1のトランジスタ及び駆動トランジスタ、第1及び第2の端子、第1の制御用端子及び駆動トランジスタの制御用端子は、一例を挙げれば、後述する本実施形態の図3に示した画素回路20において、それぞれ、駆動トランジスタTrd、駆動トランジスタTrdのドレイン及びソース、駆動トランジスタTrdのゲートに対応している。

【0068】

また、第2のトランジスタ及び調整用トランジスタ、第3及び第4の端子、第2の制御用
50

端子は、一例を挙げれば、本実施形態の図3に示した画素回路20において、それぞれ、調整用トランジスタTrc、調整用トランジスタTrcのドレイン、ソース及びゲートに対応している。

【0069】

さらに、第3のトランジスタ、第5の端子、第6の端子、第3の制御用端子は、一例を挙げれば、本実施形態の図3に示した画素回路20において、それぞれ、スイッチングトランジスタTrs、スイッチングトランジスタTrsのソース(キャパシタC1に接続された端子)、スイッチングトランジスタTrsのドレイン(データ線Xmに接続された端子)、スイッチングトランジスタTrsのゲートに対応している。

【0070】

【発明の実施の形態】

(第1実施形態)

以下、本発明を具体化した第1実施形態を図1～4に従って説明する。図1は、電気光学装置としての有機ELディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。図2は、アクティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成を示すブロック回路図である。図3は画素回路の回路図である。図4は画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである。

【0071】

有機ELディスプレイ10は、図1に示すように、信号生成回路11、アクティブマトリクス部12、走査線駆動回路13、データ線駆動回路14及び電源線制御回路15を備えている。

【0072】

有機ELディスプレイ10の信号生成回路11、走査線駆動回路13、データ線駆動回路14及び電源線制御回路15は、それぞれが独立した電子部品によって構成されていてもよい。例えば、信号生成回路11、走査線駆動回路13、データ線駆動回路14及び電源線制御回路15が、各々1チップの半導体集積回路装置によって構成されていてもよい。又、信号生成回路11、走査線駆動回路13、データ線駆動回路14及び電源線制御回路15の全部若しくは一部がプログラマブルなICチップで構成され、その機能がICチップに書き込まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。

【0073】

信号生成回路11は、図示しない外部装置からの画像データに基づいてアクティブマトリクス部12に画像を表示するための走査制御信号及びデータ制御信号を作成する。そして、信号生成回路11は、走査制御信号を走査線駆動回路13に出力するとともに、データ制御信号をデータ線駆動回路14に出力する。更に、信号生成回路11は、電源線制御回路15に対してタイミング制御信号を出力する。

【0074】

アクティブマトリクス部12は、図2に示すように、発光層が有機材料で構成された電子素子又は電気光学素子としての有機EL素子21を有する複数の単位回路としての画素回路20がマトリクス状に配設された電子回路を有している。つまり、画素回路20は、列方向に沿って延びるM本のデータ線Xm(m=1～M;mは整数)と、行方向に沿って延びるN本の走査線Yn(n=1～N;nは整数)との交差部に対応する位置に配設されている。

【0075】

又、画素回路20は、その行方向に沿って延びる第1の電源線L1及び第2の電源線L2と接続されている。第1及び第2の電源線L1,L2は、それぞれ、アクティブマトリクス部12の右端側に設けられた画素回路20の列方向に沿って延びる電圧供給線VLに接続されている。尚、画素回路20内に配置形成される後述するトランジスタは、通常はTFT(薄膜トランジスタ)で構成されている。

【0076】

走査線駆動回路13は、信号生成回路11から出力される走査制御信号に基づいて、アク

10

20

30

40

50

ティプマトリクス部 1 2 に設けられた N 本の走査線 Y n のうち、 1 本の走査線を選択し、 その選択された走査線に走査信号を供給する。

【 0 0 7 7 】

データ線駆動回路 1 4 は、 複数の単一ラインドライバ 2 3 を備えている。各単一ラインドライバ 2 3 は、 アクティプマトリクス部 1 2 に設けられた対応するデータ線 X m とそれぞれ接続されている。単一ラインドライバ 2 3 は、 それぞれ、 信号生成回路 1 1 から出力されたデータ制御信号に基づいて、 信号としてのデータ電圧 V data を生成する。又、 単一ラインドライバ 2 3 は、 その生成されたデータ電圧 V data をデータ線 X m を介して画素回路 2 0 に出力する。画素回路 2 0 は、 この出力されたデータ電圧 V data に応じて同画素回路 2 0 の内部状態が設定されることで、 各有機 EL 素子 2 1 に流れる駆動電流 I el (図 3 参照) を制御して、 有機 EL 素子 2 1 の輝度階調を制御するようになっている。また、 データ線駆動回路 1 4 の各単一ラインドライバ 2 3 は、 後述するデータ書き込み期間 T 1 において、 データ電圧 V data を供給する前に電圧供給線 V L から供給される駆動電圧 V dd と同じ電位のバイアス電圧を各画素回路 2 0 に供給するようになっている。

10

【 0 0 7 8 】

電源線制御回路 1 5 は、 後述する制御用トランジスタ Q のゲートと電源線制御線 F を介して接続されている。電源線制御回路 1 5 は、 信号生成回路 1 1 からのタイミング制御信号に基づいて、 走査信号と完全、 あるいは、 1 部時間的に重なる期間で、 制御用トランジスタ Q をオン状態にする電源線制御信号を生成し、 供給する。そして、 制御用トランジスタ Q がオン状態となると、 第 1 の電源線 L 1 を介して駆動電圧 V dd が各画素回路 2 0 に供給されるようになっている。

20

【 0 0 7 9 】

このように構成された有機 EL ディスプレイ 1 0 のアクティプマトリクス部 1 2 を構成する画素回路 2 0 について以下に説明する。尚、 各画素回路 2 0 の回路構成は同じであるので、 説明の便宜上、 1 つの画素回路について説明する。

【 0 0 8 0 】

画素回路 2 0 は、 図 3 に示すように、 3 つのトランジスタと 2 つのコンデンサとを備えている。詳しくは、 画素回路 2 0 は、 図 3 に示すように、 駆動トランジスタ T rd 、 調整用トランジスタ T rc 及びスイッチングトランジスタ T rs を備えている。又、 画素回路 2 0 は、 容量素子又は保持素子としての第 1 キャパシタ C 1 と第 2 キャパシタ C 2 を備えている。

30

駆動トランジスタ T rd 、 調整用トランジスタ T rc 及び制御用トランジスタ Q の導電型は、 それぞれ、 p 型 (p チャネル) で構成されている。又、 スイッチングトランジスタ T rs の導電型は、 n 型 (n チャネル) で構成されている。

40

【 0 0 8 1 】

駆動トランジスタ T rd は、 そのドレインが有機 EL 素子 2 1 の陽極に接続されている。有機 EL 素子 2 1 の陰極は接地されている。又、 駆動トランジスタ T rd のソースは第 2 の電源線 L 2 に接続されている。第 2 の電源線 L 2 は駆動電圧としての駆動電圧 V dd を供給する電圧供給線 V L と接続されている。駆動トランジスタ T rd のゲートは、 第 1 キャパシタ C 1 の第 1 の電極 L a と、 調整用トランジスタ T rc のドレインと、 第 2 キャパシタ C 2 の第 3 の電極 L c に接続されている。第 1 キャパシタ C 1 の静電容量は C a であって、 第 2 キャパシタ C 2 の静電容量は C b である。

【 0 0 8 2 】

第 1 キャパシタ C 1 の第 2 の電極 L b はスイッチングトランジスタ T rs のソースに接続されている。スイッチングトランジスタ T rs のドレインはデータ線 X m に接続されている。また、 スイッチングトランジスタ T rs のゲートは走査線 Y n に接続されている。

40

【 0 0 8 3 】

調整用トランジスタ T rc は、 そのゲートとドレインがノード N にて接続されている。調整用トランジスタ T rc のソースは、 他の画素回路 2 0 に設けられた他の調整用トランジ

50

スタ T_{rc} のソースとともに第 1 の電源線 L_1 に接続されている。第 1 の電源線 L_1 はアクティブマトリクス部 12 の右端側に設けられた電圧供給線 V_L に制御用トランジスタ Q を介して接続されている。詳述すると、制御用トランジスタ Q は、その第 7 の端子としてのドレインが第 1 の電源線 L_1 に接続されている。第 8 の端子としての制御用トランジスタ Q のソースは、電圧供給線 V_L に接続されている。また、制御用トランジスタ Q のゲートは、電源線制御線 F が接続されている。電源線制御線 F は電源線制御回路 15 に接続されている。

【 0 0 8 4 】

電源線制御回路 15 は電源線制御線 F を介して制御用トランジスタ Q を導通制御するための電源線制御信号 S_{CF} を供給するようになっている。そして、電源線制御回路 15 から制御用トランジスタ Q をオン状態にする電源線制御信号 S_{CF} が output されると、制御用トランジスタ Q がオン状態になる。その結果、駆動電圧 V_{dd} が調整用トランジスタ T_{rc} のソースに印加されることとなる。

【 0 0 8 5 】

第 2 キャパシタ C_2 の第 4 の電極 L_d は駆動トランジスタ T_{rd} のソースと共に第 2 の電源線 L_2 に接続されている。

【 0 0 8 6 】

本実施形態においては、調整用トランジスタ T_{rc} は、その閾値電圧 V_{th2} が駆動トランジスタ T_{rd} の閾値電圧 V_{th1} とほぼ等しくなるように形成されている。又、駆動電圧 V_{dd} はデータ電圧 V_{data} と比べて十分高くなるように設定されている。

【 0 0 8 7 】

次に、上述のように構成された有機 EL ディスプレイ 10 の画素回路 20 の駆動方法について図 4 に従って説明する。なお、図 4 において、 T_c 、 T_1 及び T_2 は、それぞれ、駆動周期、データ書き込み期間及び発光期間を表している。駆動周期 T_c は、データ書き込み期間 T_1 と発光期間 T_2 とから構成されている。駆動周期 T_c は、有機 EL 素子 21 の輝度階調が更新される周期を意味しており、本実施形態では、フレームに対応している。

【 0 0 8 8 】

まず、データ書き込み期間 T_1 において、スイッチングトランジスタ T_{rs} がオフした状態で、電源線制御回路 15 から電源線制御線 F を介して制御用トランジスタ Q をオン状態にする電源線制御信号 S_{CF} が output される。すると、制御用トランジスタ Q がオン状態となり、それにより、制御用トランジスタ Q が接続されている第 1 の電源線 L_1 に駆動電圧 V_{dd} が output される。

【 0 0 8 9 】

これにより、調整用トランジスタ T_{rc} のソースの電位は駆動電圧 V_{dd} になるとともに、ゲートの電位、即ちノード N の電位 V_n は駆動電圧 V_{dd} から調整用トランジスタ T_{rc} の閾値電圧 (V_{th2}) を引いた電圧 ($V_n = V_{dd} - V_{th2}$) になる。そして、電位 V_n が初期電位 V_{c1} として第 1 キャパシタ C_1 及び第 2 キャパシタ C_2 に保持され、駆動トランジスタ T_{rd} のゲートに供給される。

【 0 0 9 0 】

また、このとき、走査線駆動回路 13 からは走査線 Y_n を介してスイッチングトランジスタ T_{rs} のゲートにスイッチングトランジスタ T_{rs} をオフ状態にする走査信号 S_{C1} が供給されており、スイッチングトランジスタ T_{rs} はオフ状態になっている。

【 0 0 9 1 】

その後、電源線制御回路 15 から電源線制御線 F を介して制御用トランジスタ Q をオフ状態にする電源線制御信号 S_{CF} が output され、制御用トランジスタ Q がオフ状態になり、調整用トランジスタ T_{rc} のソースが電源線制御回路 15 と電気的に切断した状態となる。その結果、調整用トランジスタ T_{rc} のドレインは駆動電圧 V_{dd} から電気的に切り離された状態、すなわちフローティング状態となる。

【 0 0 9 2 】

続いて、走査線駆動回路 13 から走査線 Y_n を介してスイッチングトランジスタ T_{rs} の

10

20

30

40

50

ゲートにスイッチングトランジスタ T_{r s} をオン状態にする走査信号 S_{C 1} が供給され、スイッチングトランジスタ T_{r s} がオン状態になる。

【0093】

スイッチングトランジスタ T_{r s} がオン状態となっている期間に、データ線駆動回路 14 からデータ線 X_m 及びスイッチングトランジスタ T_{r s} を介して画素回路 20 にデータ電圧 V_{data} が供給される。

【0094】

このことによって、初期電位 V_{c 1} は、第 1 キャパシタ C₁ の静電容量 C_a 及び第 2 キャパシタ C₂ の静電容量 C_b を用いると、以下の式で表わす値に変化する。

$$V_{c 1} = V_{dd} - V_{th 2} + C_a / (C_a + C_b) \cdot V_{data}$$

10

【0095】

ここで、V_{data} は、駆動電圧 V_{dd} とデータ電圧 V_{data} との電位差 (= V_{dd} - V_{data}) である。そして、この V_{dd} - V_{th 2} + C_a / (C_a + C_b) · V_{data} が最終電位 V_{c 2} として駆動トランジスタ T_{r d} のゲートに供給される。

【0096】

最終電位 V_{c 2} に応じて、駆動トランジスタ T_{r d} の導通状態が設定され、その導通状態に応じた駆動電流 I_{e 1} が有機 EL 素子 21 に供給される。この電流 I_{e 1} は、駆動トランジスタ T_{r d} のゲート電圧 V_g とソース電圧 V_s との電圧差を V_{gs} で表すと、以下のように表される。

$$I_{e 1} = (1/2) (-V_{gs} - V_{th 1})^2$$

20

【0097】

ここで、は利得係数であって、キャリアの移動度を μ、ゲート容量を A、チャネル幅を W、チャネル長を L で表すと、利得係数 β = (μ A W / L) となる。なお、駆動トランジスタ T_{r d} のゲート電圧 V_g は最終電位 V_{c 2} である。つまり、駆動トランジスタ T_{r d} のゲート電圧 V_g とソース電圧 V_s との電圧差 V_{gs} は以下のように表される。

$$V_{gs} = V_{dd} - [V_{dd} - V_{th 2} + C_a / (C_a + C_b) \cdot V_{data}]$$

【0098】

従って、駆動トランジスタ T_{r d} の駆動電流 I_{e 1} は以下のように表される。

$$I_{e 1} = (1/2) [V_{th 2} - C_a / (C_a + C_b) \cdot V_{data} - V_{th 1}]^2$$

30

【0099】

ここで、調整用トランジスタ T_{r c} の閾値電圧 V_{th 2} は、上述したように、駆動トランジスタ T_{r d} の閾値電圧 V_{th 1} とほぼ等しくなるように設定してあるので、駆動電流 I_{e 1} は以下のように表される。

$$\begin{aligned} I_{e 1} &= (1/2) \beta [V_{th 2} - C_a / (C_a + C_b) \cdot \Delta V_{data} - \\ &V_{th 1}]^2 \\ &= (1/2) \beta [C_a / (C_a + C_b) \cdot \Delta V_{data}]^2 \end{aligned}$$

【0100】

従って、上式に示されるように、駆動電流 I_{e 1} は、駆動トランジスタ T_{r d} の閾値電圧 V_{th 1} に依存することなく、データ電圧 V_{data} に対応した大きさの電流となる。そして、この駆動電流 I_{e 1} が有機 EL 素子 21 に供給され、有機 EL 素子 21 が発光することとなる。

40

【0101】

次に、データ書き込み期間 T₁ 終了後、発光期間 T₂ にて、走査線駆動回路 13 から走査線 Y_n を介してスイッチングトランジスタ T_{r s} のゲートにスイッチングトランジスタ T_{r s} をオフ状態にする走査信号 S_{C 1} が供給される。すると、スイッチングトランジスタ T_{r s} がオフ状態になる。

【0102】

この発光期間 T₂ においては、最終電位 V_{c 2} に応じて設定された駆動トランジスタ T_r

50

d の導通状態に応じた駆動電流 I_{e1} が有機 EL 素子 21 に供給されることとなる。

【 0103 】

以上のことより、各画素回路 20 の駆動トランジスタ T_{rd} の閾値電圧 V_{th1} が製造ばらつきによって相違しても駆動電流 I_{e1} はデータ電圧 V_{data} で決定される。このことから、有機 EL 素子 21 は、データ電圧 V_{data} に基づいて精度良く輝度階調が制御されることとなる。

【 0104 】

しかも、画素回路 20 を構成するトランジスタの数を少なくし、なおかつ、製造ばらつきを補償することができる。従って、画素回路 20 は、有機 EL 素子 21 の輝度階調を精度良く制御することができることに加えて歩留まりや開口率を向上させることができる有機 EL ディスプレイ 10 を提供することができる。尚、画素回路 20 を構成するトランジスタは、例えば、単結晶シリコン、多結晶シリコン、微結晶シリコン、あるいは、アモルファスシリコンのいずれかにより形成されていることが好ましい。10

【 0105 】

(第 2 実施形態)

次に、本発明を具体化した第 2 実施形態を図 5 に従って説明する。尚、本実施形態において、第 1 実施形態と同じ構成部材については符号を等しくして、その詳細な説明を省略する。

【 0106 】

図 5 は、有機 EL ディスプレイ 10 のアクティブマトリクス部 12a 及びデータ線駆動回路 14 の内部回路構成を示すブロック回路図である。本実施形態において、アクティブマトリクス部 12a は、赤色の光を放射する有機 EL 素子 21 を有した赤用画素回路 20R と、緑色の光を放射する有機 EL 素子 21 を有した緑用画素回路 20G と、青色の光を放射する有機 EL 素子 21 を有した青用画素回路 20B とで構成される。上述の各赤、緑及び青用画素回路 20R, 20G, 20B の回路構成は、それぞれ、第 1 実施形態で説明した画素回路 20 の回路構成と等しい。20

【 0107 】

詳述すると、アクティブマトリクス部 12a は、同色の画素回路 20R, 20G, 20B が走査線 Y_n の延設方向に沿って配置されている。つまり、走査線 Y_n のうち、第 1 の走査線 Y₁ には、赤色の画素回路 20R が接続されている。同様に、走査線 Y_n のうち、第 2 の走査線 Y₂ には、緑用画素回路 20G が接続されている。30

【 0108 】

同様に、走査線 Y_n のうち、第 3 の走査線 Y₃ には、青色の画素回路 20B が接続されている。そして、そのような各画素回路 20R, 20G, 20B が順次列方向に繰り返されて配置されている。又、各色の画素回路 20R, 20G, 20B に対応した制御用トランジスタ Q_R, Q_G, Q_B は、各色の画素回路 20R, 20G, 20B に対応した駆動電圧 V_{ddR}, V_{ddG}, V_{ddB} を供給する電圧供給線 V_{LR}, V_{LG}, V_{LB} と接続されている。

【 0109 】

次に、上述のように構成された有機 EL ディスプレイ 10 の画素回路 20R, 20G, 20B の駆動方法について説明する。40

【 0110 】

走査線 Y₁ を介してスイッチングトランジスタ T_{rs} をオフ状態とする走査信号が供給され、走査線 Y₁ の延設方向に配置された赤用画素回路 20R 内のスイッチングトランジスタ T_{rs} がオフ状態となっている期間に、電源線制御回路 15 から、走査線 Y₁ に対応する制御用トランジスタ Q_R をオン状態とする信号が出力される。これによって、走査線 Y₁ に接続された赤用画素回路 20R の各々に含まれる第 1 キャパシタ C₁ 及び第 2 キャパシタ C₂ には電位 V_n (= V_{dd} - V_{th2}) が初期電位 V_{c1} として保持される。

【 0111 】

その後、電源線制御回路 15 から制御用トランジスタ Q_R をオフ状態とし、さらに走査線50

Y 1 を介してスイッチングトランジスタ T r s をオン状態にする走査信号が供給される。この状態で、データ線駆動回路 1 4 の單一ラインドライバ 2 3 からデータ線 X m 及びスイッチングトランジスタ T r s を介して画素回路 2 0 にデータ電圧 V d a t a が供給される。

【 0 1 1 2 】

このことによって、初期電位 V c 1 は、第 1 キャパシタ C 1 の静電容量 C a 及び第 2 キャパシタ C 2 の静電容量 C b を用いると、以下の式で表わす値に変化する。

$$V c 1 = V d d - V t h 2 + C a / (C a + C b) \cdot V d a t a$$

【 0 1 1 3 】

そして、この V c 1 が最終電位 V c 2 として駆動トランジスタ T r d のゲートに供給される。 10

【 0 1 1 4 】

最終電位 V c 2 に応じて、駆動トランジスタ T r d の導通状態が設定され、その導通状態に応じた駆動電流 I e 1 が有機 EL 素子 2 1 に供給される。

【 0 1 1 5 】

この結果、赤用画素回路 2 0 R の有機 EL 素子 2 1 が発光する。このとき、調整用トランジスタ T r c の閾値電圧 V t h 2 は駆動トランジスタ T r d の閾値電圧 V t h 1 とほぼ等しくなるように設定されている。従って、赤用画素回路 2 0 R の各々の駆動トランジスタ T r d は、その閾値電圧 V t h 1 が補償されているので、赤用画素回路 2 0 R の有機 EL 素子 2 1 の輝度階調がデータ電圧 V d a t a に応じて精度良く制御される。 20

【 0 1 1 6 】

続いて、走査線 Y 2 に対応する緑用画素回路 2 0 G に含まれるスイッチングトランジスタ T r s をオフ状態にした状態で、電源線制御回路 1 5 から制御用トランジスタ Q G をオン状態とする信号が供給される。これにより、走査線 Y 2 に接続された緑用画素回路 2 0 G の各々の第 1 キャパシタ C 1 及び第 2 キャパシタ C 2 に電位 V n (= V d d - V t h 2) が初期電位 V c 1 として保持される。

【 0 1 1 7 】

その後、電源線制御回路 1 5 から制御用トランジスタ Q G をオフ状態とし、さらに第 2 の走査線 Y 2 を介してスイッチングトランジスタ T r s をオン状態にする走査信号が供給される。これに呼応して、データ線駆動回路 1 4 の單一ラインドライバ 2 3 からデータ線 X m を介してデータ電圧 V d a t a が供給される。 30

【 0 1 1 8 】

このことによって、初期電位 V c 1 は、第 1 キャパシタ C 1 の静電容量 C a 及び第 2 キャパシタ C 2 の静電容量 C b を用いると、以下の式で表わす値に変化する。

$$V c 1 = V d d - V t h 2 + C a / (C a + C b) \cdot V d a t a$$

【 0 1 1 9 】

そして、この V c 1 が最終電位 V c 2 として駆動トランジスタ T r d のゲートに供給される。

【 0 1 2 0 】

最終電位 V c 2 に応じて、駆動トランジスタ T r d の導通状態が設定され、その導通状態に応じた駆動電流 I e 1 が有機 EL 素子 2 1 に供給される。 40

【 0 1 2 1 】

この結果、緑用画素回路 2 0 G の有機 EL 素子 2 1 が発光する。このとき、調整用トランジスタ T r c の閾値電圧 V t h 2 は駆動トランジスタ T r d の閾値電圧 V t h 1 とほぼ等しくなるように設定されている。従って、緑用画素回路 2 0 G の各々の駆動トランジスタ T r d は、その閾値電圧 V t h 1 が補償されているので、緑用画素回路 2 0 G の有機 EL 素子 2 1 の輝度階調がデータ電圧 V d a t a に応じて精度良く制御される。

【 0 1 2 2 】

以下、走査線 Y 3 に対応して設けられた青色用画素回路 2 0 B に対しても同様な操作を行う。

【 0 1 2 3 】

通常、有機 E L 素子 2 1 は発光色により材料の特性が異なることがあるが、発光色毎に駆動電圧を設定する必要がある場合がある。そのような場合、第 2 実施形態のようなパネルレイアウトは適している。

【 0 1 2 4 】

また、発光色により有機 E L 素子の経時劣化等により駆動電圧が異なる場合は、有機 E L 素子の経時劣化の程度に応じて駆動電圧 V d d を適宜再設定することにより、有機 E L 素子の経時劣化を補償することもできる。

【 0 1 2 5 】

もちろん、上述の第 2 実施形態の概念は、有機 E L 素子以外の電子素子や電気光学素子にも適用することができる。10

【 0 1 2 6 】

(第 3 実施形態)

次に、第 1 及び第 2 実施形態で説明した電気光学装置としての有機 E L ディスプレイ 1 0 の電子機器の適用について図 6 及び図 7 に従って説明する。有機 E L ディスプレイ 1 0 は、モバイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に適用できる。10

【 0 1 2 7 】

図 6 は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図 6 において、パーソナルコンピュータ 5 0 は、キーボード 5 1 を備えた本体部 5 2 と、有機 E L ディスプレイ 1 0 を用いた表示ユニット 5 3 とを備えている。20

この場合においても、有機 E L ディスプレイ 1 0 を用いた表示ユニット 5 3 は上述の実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機 E L 素子 2 1 の輝度階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができる有機 E L ディスプレイ 1 0 を備えたモバイル型パーソナルコンピュータ 5 0 を提供することができる。

【 0 1 2 8 】

図 7 は、携帯電話の構成を示す斜視図を示す。図 7 において、携帯電話 6 0 は、複数の操作ボタン 6 1 、受話口 6 2 、送話口 6 3 、有機 E L ディスプレイ 1 0 を用いた表示ユニット 6 4 を備えている。この場合においても、有機 E L ディスプレイ 1 0 を用いた表示ユニット 6 4 は上述の実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機 E L 素子 2 1 の輝度階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができ有機 E L ディスプレイ 1 0 を備えた携帯電話 6 0 を提供することができる。30

【 0 1 2 9 】

尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように実施してもよい。

【 0 1 3 0 】

上述の実施形態では、制御回路として、制御用トランジスタ Q を使用した。これを、トランジスタ Q の変わりに低電位と高電位との間で切換える可能なスイッチを設けてもよい。又、駆動トランジスタ T r d の駆動能力を向上させるためにバッファ回路あるいはソースフォロワ回路を含むボルテージフォロワ回路を使用してもよい。このようにすることによって、速やかに画素回路に電流を供給することができる。40

【 0 1 3 1 】

上述の実施形態では、制御用トランジスタ Q 及び電圧供給線 V L をアクティブマトリクス部 1 2 の右端側に設けるようにしたが、制御用トランジスタ Q 及び電圧供給線 V L を電源線制御回路 1 5 に設けるようにしてもよい。

【 0 1 3 2 】

電圧供給線 V L をアクティブマトリクス部 1 2 に対して走査線駆動回路 1 3 と同じ側に設けてもよい。

【 0 1 3 3 】

電源線制御回路 1 5 を、アクティブマトリクス部 1 2 に対して走査線駆動回路 1 3 と同50

じ側に設けることもできる。

【0134】

上述の実施形態では、駆動トランジスタ T_{rd} 、調整用トランジスタ T_{rc} 及び制御用トランジスタ Q の導電型を p 型とし、スイッチングトランジスタ T_{rs} 及びの導電型を n 型とした。これを、駆動トランジスタ T_{rd} 及び調整用トランジスタ T_{rc} の導電型を n 型とし、スイッチングトランジスタ T_{rs} 及び制御用トランジスタ Q の導電型を p 型としてもよい。

【0135】

あるいは、上記の全てのトランジスタの導電型を同一としてもよい。

【0136】

上記の実施形態では、本発明を有機EL素子に適用した例について述べたが、もちろん、有機EL素子以外の例えばLED、FED、液晶素子、無機EL素子、電気泳動素子、電子放出素子等の種々の電気光学素子を駆動する単位回路に具体化してもよい。RAM等(特にMRAM)の記憶素子に具体化してもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施形態の有機ELディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。

【図2】第1実施形態のアクティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成を示すブロック回路図である。

【図3】第1実施形態の画素回路の回路図である。

【図4】第1実施形態の画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである。

【図5】第2実施形態のアクティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成を示すブロック回路図である。

【図6】第3実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。

【図7】第3実施形態を説明するための携帯電話の構成を示す斜視図である。

【符号の説明】

C1 容量素子又は保持素子としてのキャパシタ

L_a 第1の電極

L_b 第2の電極

T_{rd} 第1のトランジスタとしての駆動トランジスタ

T_{rc} 第2のトランジスタとしての調整用トランジスタ

T_{rs} 第3のトランジスタとしてのスイッチングトランジスタ

Q 第4のトランジスタとしての制御用トランジスタ

V_{data} 信号としてのデータ電圧

V_{dd} 駆動電圧

Y_n 走査線

X_m データ線

10 電気光学装置としての有機ELディスプレイ

20 単位回路としての画素回路

21 電子素子又は電流駆動素子としての有機EL素子

50 電子機器としてのモバイル型パーソナルコンピュータ

60 電子機器としての携帯電話

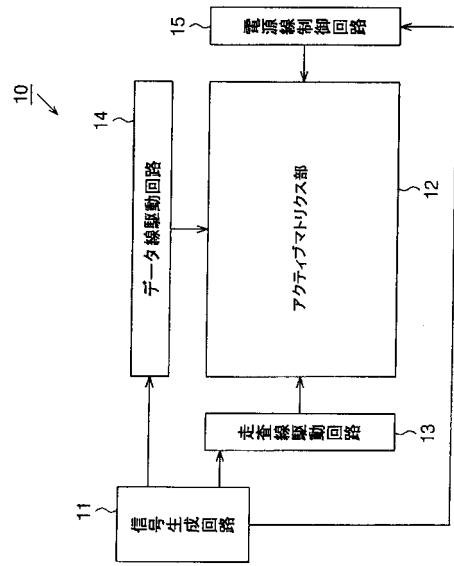
10

20

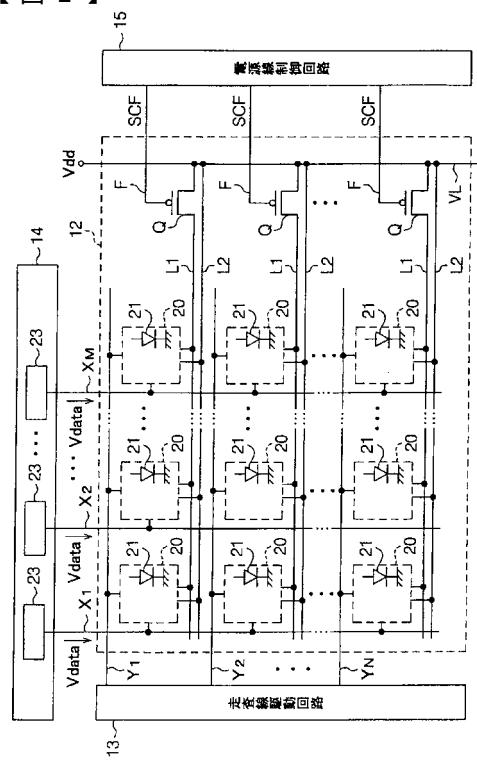
30

40

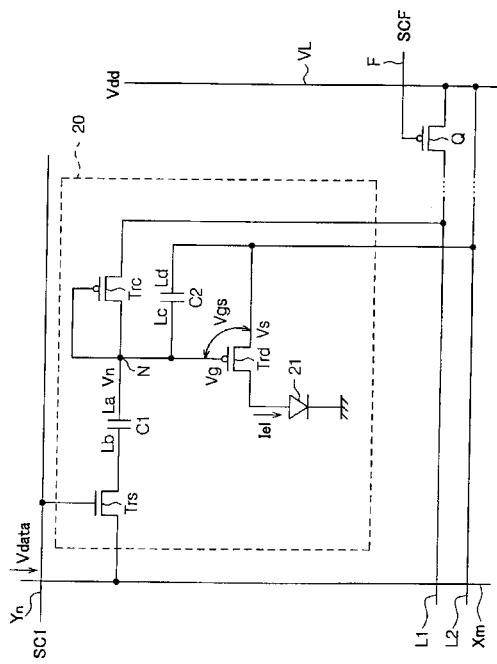
【 図 1 】



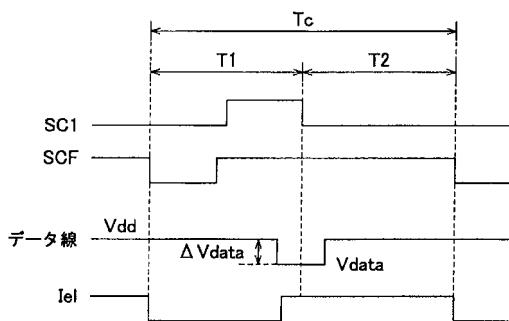
【 図 2 】



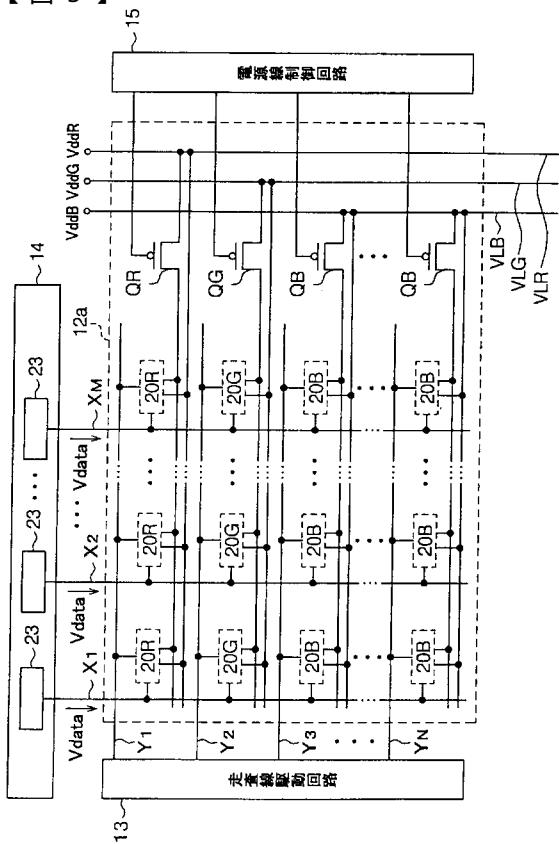
【図3】



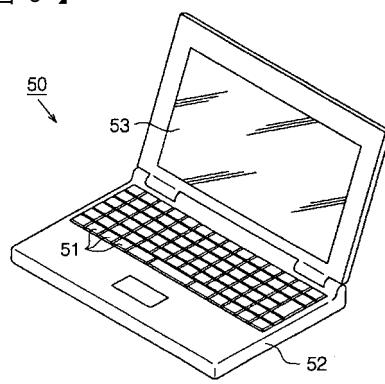
【 図 4 】



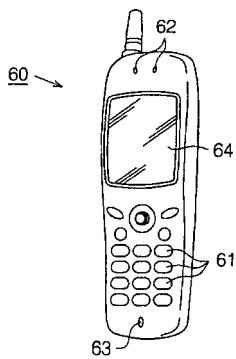
【 図 5 】



【 図 6 】



【 図 7 】



フロントページの続き(51) Int.Cl.⁷

F I

テーマコード(参考)

H 0 3 K	17/00	G
H 0 3 K	17/00	M
H 0 5 B	33/14	A

F ターム(参考) 5C080 AA06 BB05 DD05 DD22 DD25 EE29 FF11 JJ02 JJ03 JJ04
KK02 KK47
5J055 AX48 BX09 BX16 CX29 DX13 DX14 DX44 EX02 EY10 EY14
EY21 EZ39 EZ68 GX01 GX02 GX04